Fig.1

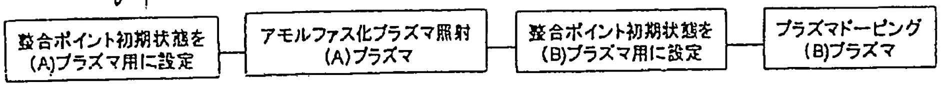

整合ポイント初期状態を
(A)プラズマ用に設定
アモルファス化プラズマ照射
(A)プラズマ
整合ポイント初期状態を
(B)プラズマ用に設定
プラズマドーピング
(B)プラズマ

Fig 2

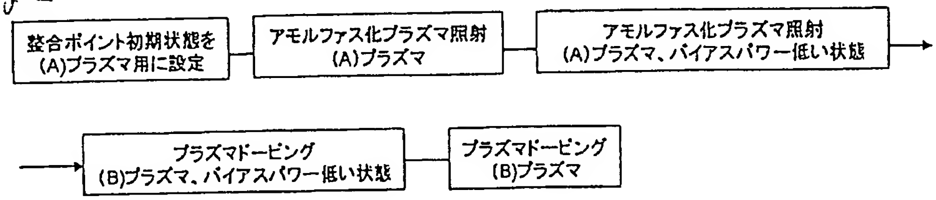

整合ポイント初期状態を
(A)プラズマ用に設定
アモルファス化プラズマ照射
(A)プラズマ
アモルファス化プラズマ照射
(A)プラズマ、バイアスパワー低い状態
プラズマドーピング
(B)プラズマ、バイアスパワー低い状態
プラズマドーピング
(B)プラズマ

Fig 3

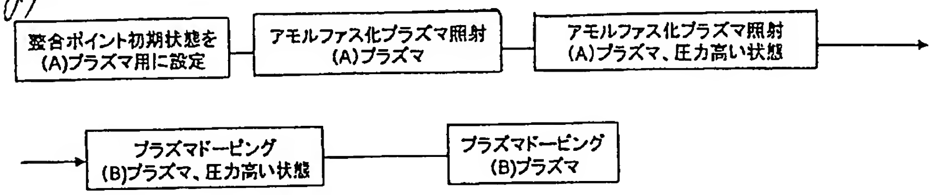

整合ポイント初期状態を
(A)プラズマ用に設定
アモルファス化プラズマ照射
(A)プラズマ
アモルファス化プラズマ照射
(A)プラズマ、圧力高い状態
プラズマドーピング
(B)プラズマ、圧力高い状態
プラズマドーピング
(B)プラズマ

Fig 4

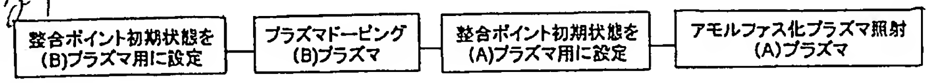

整合ポイント初期状態を
(B)プラズマ用に設定
プラズマドーピング
(B)プラズマ
整合ポイント初期状態を
(A)プラズマ用に設定
アモルファス化プラズマ照射
(A)プラズマ

Fig 5

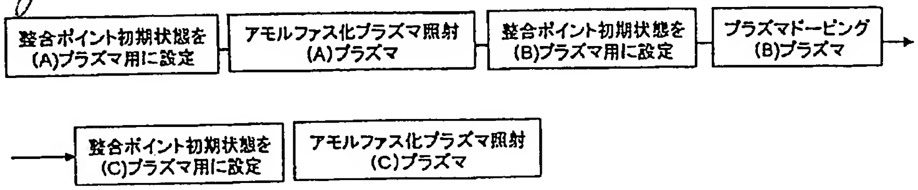
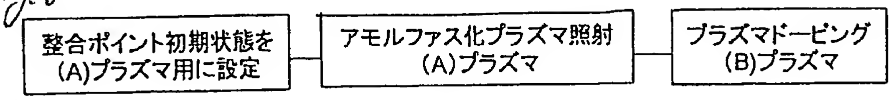

整合ポイント初期状態を
(A)プラズマ用に設定
アモルファス化プラズマ照射
(A)プラズマ
整合ポイント初期状態を
(B)プラズマ用に設定
プラズマドーピング
(B)プラズマ
整合ポイント初期状態を
(C)プラズマ用に設定
アモルファス化プラズマ照射
(C)プラズマ

Fig.6


整合ポイント初期状態を
(A)プラズマ用に設定
アモルファス化プラズマ照射
(A)プラズマ
プラズマドーピング
(B)プラズマ

[Fig.1]

[MATCHING POINT INITIAL CONDITION IS SET TO ONE FOR USE IN (A) PLASMA]-[PLASMA IRRADIATION FOR REALIZATION AMORPHOUS (A) PLASMA]-[MATCHING POINT INITIAL CONDITION IS SET TO ONE FOR USE IN (B) PLASMA]-[PLASMA DOPING (B) PLASMA]

[Fig.2]

[MATCHING POINT INITIAL CONDITION IS SET TO ONE FOR USE IN (A) PLASMA]-[PLASMA IRRADIATION FOR REALIZATION AMORPHOUS (A) PLASMA]-[PLASMA IRRADIATION FOR REALIZATION OF AMORPHOUS (A) PLASMA, BIAS POWER LOW SITUATION]-[PLASMA DOPING (B) PLASMA, BIAS POWER LOW SITUATION]-[PLASMA DOPING (B) PLASMA]

[Fig.3]

[MATCHING POINT INITIAL CONDITION IS SET TO ONE FOR USE IN (A) PLASMA]-[PLASMA IRRADIATION FOR REALIZATION AMORPHOUS (A) PLASMA]-[PLASMA IRRADIATION FOR REALIZATION OF AMORPHOUS (A) PLASMA, PRESSURE HIGH SITUATION]-[PLASMA DOPING (B) PLASMA, PRESSURE HIGH SITUATION]-[PLASMA DOPING (B) PLASMA]

[Fig.4]

[MATCHING POINT INITIAL CONDITION IS SET TO ONE FOR USE IN (B) PLASMA]-[PLASMA DOPING (B) PLASMA]-[MATCHING POINT INITIAL CONDITION IS SET TO ONE FOR USE IN (A) PLASMA]-[PLASMA IRRADIATION FOR REALIZATION OF AMORPHOUS (A) PLASMA]

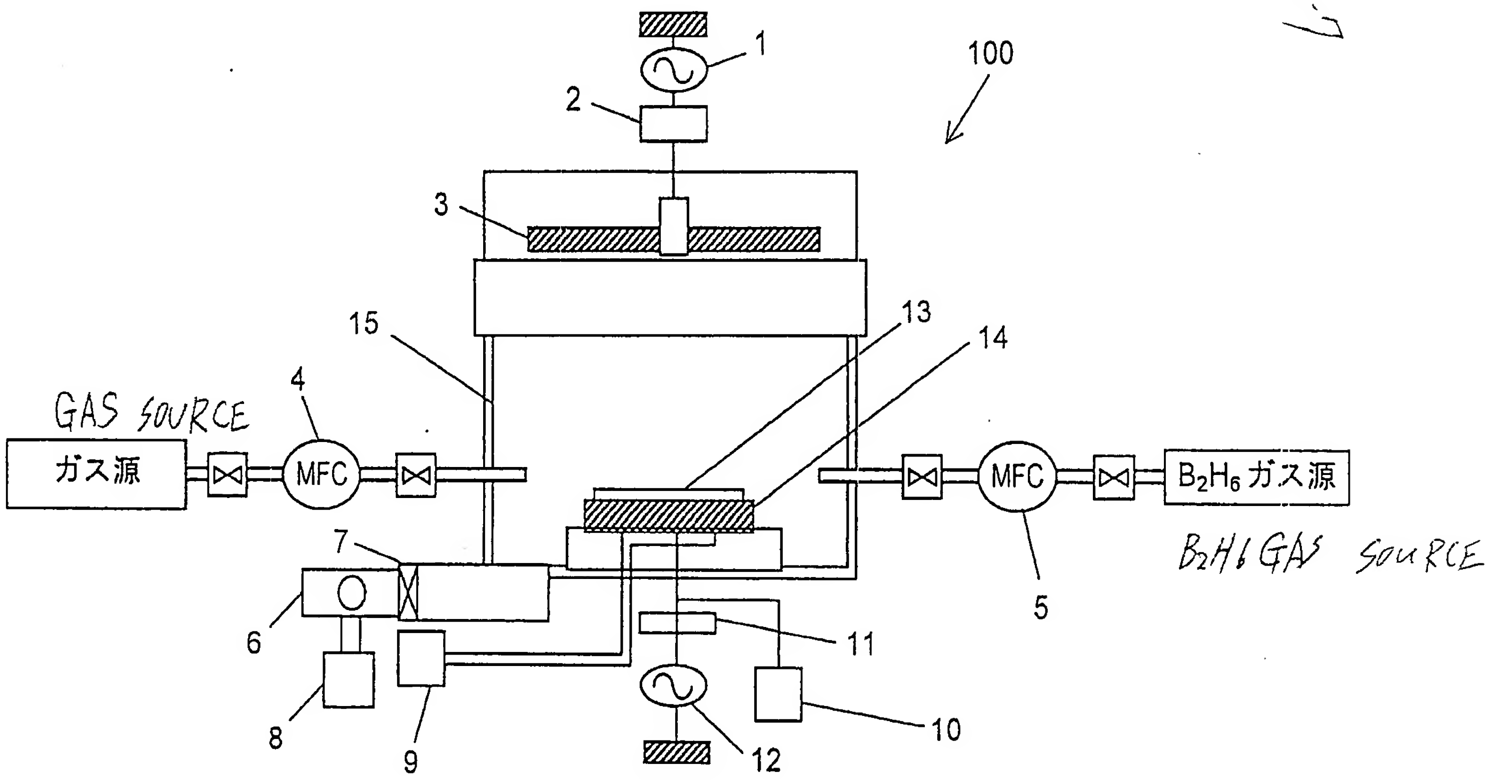
[Fig.5]

[MATCHING POINT INITIAL CONDITION IS SET TO ONE FOR USE IN (A) PLASMA]-[PLASMA IRRADIATION FOR REALIZATION AMORPHOUS (A) PLASMA]-[MATCHING POINT INITIAL CONDITION IS SET TO ONE FOR USE IN (B) PLASMA]-[PLASMA DOPING (B) PLASMA]-[MATCHING POINT INITIAL CONDITION IS SET TO ONE FOR USE IN (C) PLASMA][PLASMA IRRADIATION FOR REALIZATION OF AMORPHOUS (C) PLASMA]

[Fig.6]

[MATCHING POINT INITIAL CONDITION IS SET TO ONE FOR USE IN (A) PLASMA]-[PLASMA IRRADIATION FOR REALIZATION AMORPHOUS (A) PLASMA]-[PLASMA DOPING (B) PLASMA]

Fig. 7


GAS SOURCE
ガス源
MFC
MFC
B_2H_6ガス源
B_2H_6 GAS SOURCE